

**Программа кандидатского экзамена по научной специальности
05.27.06 Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники**

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Материалы электронной техники и технологии их получения

Общая классификация материалов по составу, свойствам и техническому назначению. Физическая природа электропроводности металлов, сплавов, полупроводников, диэлектриков и композиционных материалов; сверхпроводящие металлы и сплавы; характеристика проводящих и резистивных материалов во взаимосвязи с их применением в электронной технике.

Элементарные полупроводники. Физико-химические, электрофизические и оптические свойства. Современные методы выращивания монокристаллов элементарных полупроводников. Принципы выращивания структурно совершенных монокристаллов. Микродефекты в монокристаллах кремния.

Полупроводниковые соединения $A^{III}B^V$. Физико-химические, электрофизические и оптические свойства. Синтез и выращивание объемных монокристаллов соединений $A^{III}B^V$ в связи с Р-Т-Х диаграммами. Методы кристаллизации и легирования. Тройные диаграммы состояния $A^{III}B^V$ – примесь. Компенсация и получение полуизолирующих кристаллов. Специфика подготовки подложек различных соединений $A^{III}B^V$. Влияние кристаллографических ориентаций. Травление жидкостное, расплавное, газовое.

Получение широкозонных материалов – нитриды галлия, алюминия, бора. Эпитаксия арсенида галлия, фосфида галлия, арсенида индия, антимонида индия и твердых растворов. Применение соединений $A^{III}B^V$ в СВЧ-технике, оптоэлектронике, квантовой электронике.

Полупроводниковые соединения $A^{II}B^{VI}$ и $A^{IV}B^{VI}$. Физико-химические, электрофизические и оптические свойства. Синтез и выращивание монокристаллов соединений с двумя летучими компонентами. Методы выращивания монокристаллов из газовой фазы и из расплава. Эпитаксия соединений. Методы управления стехиометрическим составом. Термообработка. Особенности получения соединений: сульфида кадмия, селенида кадмия, теллурида кадмия, сульфида свинца, твердых растворов. Области применения кристаллов: лазеры, оптические модуляторы, акустоэлектронные приборы, ИК-фотоприемники.

Аморфные полупроводники. Аморфный кремний и сплавы на его основе. Применение аморфного кремния в фотоэлектрических преобразователях.

Понятие о физико-химических механизмах переключения памяти и оптической записи информации в халькогенидных стеклах. Особенности стеклообразования в халькогенидных системах и в оксидных системах. Синтез стеклообразных полупроводников и их свойства.

Материалы вакуумной электроники. Требования к чистоте материалов и их газосодержанию. Основные требования, предъявляемые к материалам для получения вакуумплотных соединений. Особенности технологии изготовления корпусов ИС на основе металлов и стекловидных материалов: стеклок, ситаллов и композиционных материалов.

2. Материалы оптоэлектроники.

Излучательные свойства твердых тел. Излучение света в полупроводниках. Полупроводники с прямой и непрямой запрещенной зоной. Иттрий-алюминиевый гранат: структура, важнейшие физические свойства. Диаграмма плавкости и факторы, благоприятствующие кристаллизации гранатовой фазы. Методы выращивания, характерные ростовые дефекты и методы борьбы с ними. Термодиффузионное получение композитных активных элементов. Лазерная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната. Прочие упорядоченные кристаллические матрицы для редкоземельных ионов (алюминат иттрия, ванадаты, сесквиоксиды и лазерная керамика на их основе). Разупорядоченные кристаллические матрицы для редкоземельных ионов, а также лазерные стекла и волокна.

Лазерные кристаллы, легированные переходными 3d-ионами ($Ti^{3+}:Al_2O_3$, $Cr^{3+}:BeAl_2O_4$, $Cr^{4+}:Y_3Al_5O_{12}$, $Cr^{4+}:Mg_2SiO_4$), а также кристаллы для пассивных лазерных затворов ($V^{3+}:Y_3Al_5O_{12}$, $Co^{2+}:MgAl_2O_4$): структура, физико-химические и спектрально-генерационные характеристики, особенности выращивания монокристаллов. Проблемы управления зарядовым состоянием ионов-активаторов.

Самоактивированные и примесно-активированные люминофоры. Активаторные примеси для люминофоров и сцинтилляторов, требования, предъявляемые к ним. Требования, предъявляемые к люминофорным и сцинтилляторным матрицам. Монокристаллы вольфрамата свинца. Физико-химические и эксплуатационные свойства. Получение монокристаллов. Типичные дефекты. Техника безопасности. Щелочно-галогенидные сцинтилляторные кристаллы, структура и свойства, выращивание крупных кристаллов, области применения. Монокристаллы фторида церия. Физико-химические и эксплуатационные свойства. Методы получения кристаллов. Влияние атмосферы на качество кристаллов. Тигельные материалы. Типичные дефекты. Техника безопасности. Области применения. Краткий обзор современных порошкообразных люминофоров. Основные методы их синтеза.

Лазерные кристаллы фторидов: общие отличительные особенности физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств, преимущества и недостатки по сравнению с оксидными кристаллами. Проблемы технологии получения высокопрозрачных монокристаллов и методы глубокой очистки ростовой зоны от воды и кислорода. Фторидные оптические кристаллы со структурами поваренной соли, флюорита, шеелита и кордиерита. Фторидная лазерная керамика и нано-стеклокерамика.

Ниобат лития: Структура и фазовые превращения, физико-химические характеристики, фазовая диаграмма и особенности технологии выращивания кристаллов. Конгруэнтные и стехиометрические кристаллы LiNbO_3 . Технологические дефекты и возможности их устранения. Доменное строение, кристаллы с регулярной доменной структурой и их применение, монодоменизация кристаллов. Специфика LiTaO_3 . Монокристаллы калий-титанил-фосфата. Состав, фазовые переходы, структура и основные физико-химические свойства. Выращивание кристаллов из раствора в расплаве. Области применения и проблема «серых треков». Краткий обзор других нелинейно-оптических кристаллов (BBO, LBO, KDP).

Пьезо- и сегнетоэлектрики. Особенности структуры и сегнетоэлектрический фазовый переход. Кварц. Структура, полиморфные модификации, физико-химические свойства кварца. Выращивание крупных монокристаллов гидротермальным методом, работа в "перевернутом" и рабочем режимах. Технологические параметры, оказывающие наибольшее влияние на скорость роста и качество монокристаллов. Области применения кристаллов. Лангасит как альтернатива синтетическому кварцу. Структура, свойства и выращивание кристаллов. Краткий обзор других пьезо- и сегнетоэлектрических кристаллов. Монокристаллы ниобата бария-натрия и ниобата бария-стронция как электрооптические и фоторефрактивные материалы: физико-химические свойства, структура полиморфных модификаций. Диаграммы плавкости систем, монокристаллы конгруэнтного и стехиометрического SBN, их преимущества, недостатки и особенности выращивания, области применения.

Ферриты со структурой шпинели, граната, перовскита и гексаплумбита. Би- и полиферриты. Основные методы получения кристаллов ферритов. Физико-химические характеристики и методы получения монокристаллов железо-иттриевого граната. Дефекты в кристаллах. Получение монокристаллических эпитаксиальных пленок железо-иттриевого граната. Основные области применения ферритов. Магнитооптические изоляторы на фарадеевском эффекте. Монокристаллы ТГГ и ТСАГ, физико-химические свойства и особенности выращивания.

Корунд как важнейший функциональный и подложечный монокристалл. Основные физико-химические свойства, структура. Выращивание кристаллов методами Чохральского и Багдасарова, их достоинства и недостатки применительно к технологии корунда. Проблема тигельного материала. Получение очень крупных кристаллов корунда методом ГОИ. Получение кристаллов различных форм методом Степанова. Дефекты в кристаллах, методы их контроля и способы устранения. Фианит, его основные свойства и сферы применения. Структурные модификации и способы их стабилизации, ЧСЦ. Выращивание кристаллов методом холодного контейнера. Краткий обзор других функциональных и подложечных материалов. Материалы акустоэлектроники. Пьезоэлектрики. Пьезоэлектрические свойства монокристаллов и текстурированных материалов. Сегнетоэлектрики.

3. Наноматериалы.

Современные технологические методы формирования наноструктурированных материалов. Методы литографии высокого разрешения. Эпитаксиальные методы. Электрохимические методы. Золь-гель технология. Методы молекулярного наслаивания.

Органические материалы в электронной технике. Органические полимерные диэлектрики. Материалы для органических светоизлучающих диодных структур (ОСИД). Применение металлоорганических соединений (МОС) в микроэлектронике. Применение металлоорганических соединений для получения чистых металлов, диэлектрических пленок, полупроводниковых соединений.

Неорганические стекловидные диэлектрики в электронной технике и в микроэлектронике. Требования к диэлектрикам различного назначения и области их применения: подложки, материалы для бескорпусной защиты, пассивации, герметизации ИС, межслойной и межкомпонентной изоляции ИС, трехмерных структур, структур «кремний на изоляторе», изоляции электродов газоразрядных индикаторных панелей, элементов интегральной оптики и акустоэлектроники.

Сверхпроводящие материалы. Кристаллическая структура и изотипический эффект. Эффект Джозефсона. Высокотемпературные керамические сверхпроводники. Технология изготовления.

Фоторезисты. Определение и классификация. Требования к фоторезистам. Электронорезисты и рентгенорезисты.

Особо чистые элементы и материалы, их роль в современной технике. Понятие о чистоте вещества, методы определения и оценка чистоты. Физико-химические основы глубокой очистки веществ. Понятие о коэффициенте разделения и распределения. Методы очистки. Зонная очистка. Сублимация.

Ректификация. Хроматографическая очистка. Экстракция, Электролиз. Методы получения гидридов, хлоридов металлов и металлоорганических соединений.

4. Технология получения структур микроэлектроники

Методы эпитаксии кремния из газовой фазы. Легирование и автолегирование. Особенности выращивания структур со скрытыми слоями. Газофазная эпитаксия. Хлоридный, хлоридно-гидридный и МОС-гидридный методы. Жидкостная эпитаксия и области ее применения. Механизм кристаллизации из раствора в расплаве Фазовое равновесие. Равновесная и неравновесная кристаллизация. Коэффициент распределения примесей. Молекулярно-лучевая эпитаксия.

Структуры для СВЧ-транзисторов, диодов Ганна и Шоттки. Особенности получения тонких слоев с заданной неоднородностью распределения примесей.

Структуры со скрытыми слоями. Получение структур с диэлектрическими и поликристаллическими слоями.

Структуры «кремний на изоляторе» (КНИ). Методы прямого и непрямого сращивания для формирования структур КНИ. Глубокая имплантация ионов кислорода и азота. Дефекты в ионно-имплантированных структурах КНИ. Формирование КНИ-структур методом окисления пористого кремния. Технология получения гетерослоев кремния на сапфире. Особенности получения и электрофизические свойства слоев.

Структуры полупроводник-диэлектрик. Методы получения и основные электрофизические свойства структур диэлектрик-германий. Структуры диэлектрик – антимонид индия. Технология получения структур электрохимическим окислением. Электрофизические свойства структур. Основные нестабильности и методы их уменьшения.

Структуры оптоэлектроники. Технология получения гетероструктур для лазеров и светодиодов. Планарные и каналные оптические волноводы. Особенности получения многослойных структур. Технология получения структур для солнечных батарей.

Процессы толсто пленочной технологии. Приготовление порошков и паст для проводников и резисторов на основе палладия, серебра, золота, рутения, иридия, кадмия. Получение резисторов на основе окислов редких металлов, боридов, карбидов и нитридов. Приготовление порошков и диэлектрических паст на основе титанатов бария, кальция, висмута и др.

Методы нанесения тонких пленок в вакууме: вакуум-термический, термоионный, электронно-лучевой, ионно-плазменный (с использованием

разрядов на постоянном токе (ПТ), а также ВЧ и СВЧ разрядов), с помощью автономных ионных источников. Магнетронные распылительные системы.

Процесс ионного распыления материалов. Особенности распыления металлов и диэлектриков. Зависимость коэффициентов распыления различных факторов. Закономерности удаления материала с распыляемой поверхности и особенности их использования в технологических процессах микроэлектронного производства. Применение ионно-плазменных распылительных систем для нанесения и травления материалов.

Активные индикаторы. Электронно-лучевые трубки, светоизлучающие диоды, электролюминесцентные, газоразрядные индикаторы и др. Пассивные индикаторы. Жидкокристаллические, электрохромные индикаторы, индикаторы на PLZT- керамике и др. Сравнительные характеристики активных и пассивных индикаторов. Жидкокристаллические материалы. Основные электрооптические эффекты в жидких кристаллах.

Нанотехнология. Современные технологические методы формирования наноструктур. Процессы самоорганизации и самоформирования в технологии наноструктур. Проблемы создания упорядоченных наноструктурированных материалов на большой площади.

5. Методы исследования материалов и элементов электронной техники

Методы измерения электрических параметров полупроводников. Измерение подвижности, удельного сопротивления, концентрации носителей, доноров и акцепторов. Способы измерения толщины эпитаксиальных слоев. Характеристики однородности электрических свойств слоев на площади и толщине. Методы определения профиля распределения легирующих примесей. Измерение электрофизических параметров структур диэлектрик-полупроводник методом вольтфарадных характеристик.

Методы исследования реальной структуры кристаллов, определения фазового состава, прецизионного измерения параметров решетки. Методы изучения объемных дефектов. Дифракция медленных электронов. Обратное рассеяние ионов.

Исследование строения поверхностных слоев монокристаллов. Метод Берга-Барретта. Оценка совершенства кристаллов с помощью двухкристального спектрометра. Методы просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии и примеры ее использования.

Оптические методы металлографических исследований. Наблюдение объектов в поляризованном свете. Топография поверхности. Наблюдение микродефектов поверхности эпитаксиальных слоев. Принципы двухлучевой и многолучевой интерферометрии и их применение. Выявление дислокаций

методом травления. Механизм формирования ямок травления на дислокациях.

Методы определения химического состава. Химические методы анализа: экстракция, хроматография, полярография, потенциометрия. Объемный анализ. Гравиметрия. Спектральный анализ. Атомно-адсорбционный анализ. Люминисцентный метод. Молекулярная спектроскопия. Электронный парамагнитный резонанс, ядерный парамагнитный резонанс. Нейтронно-активационный анализ. Метод радиоактивных индикаторов, Оже-спектроскопия, рентгено-флуоресцентный анализ, лазерная и вторично-ионная масс-спектроскопия.

Методы определения деформаций в структурах микроэлектроники. Определение тензора деформаций с помощью двукристалльной рентгеновской дифрактометрии. Полярография. Определение деформаций по прогибу пластин.

Методы исследования наноструктур. Электронная микроскопия. Оптика ближнего поля. Туннельная и атомно-силовая микроскопия.

6. Технология и оборудование производства изделий электронной техники

Современные тенденции развития технологии СБИС и УБИС. Нанотехнология. Основные требования технологии к разрабатываемому технологическому оборудованию (ТО), направления развития ТО. Методы проектирования технологического оборудования для получения субмикронных и наноразмерных структур. Системный подход к выбору оптимальных технических решений методами моделирования и формально эвристического проектирования.

Обеспечение и поддержание в чистых помещениях среды с заданными параметрами. Проблема привносимой дефектности при производстве СБИС. Экологические аспекты субмикронной и нанотехнологии. Модели выхода годных СБИС. Принципы организации чистых производственных помещений. Создание средств технологической экологии при производстве СБИС и УБИС. Транспортные и загрузочные системы микроэлектроники (подвижные работы, туннельно-трековые системы, системы со стандартным механическим интерфейсом (СМИФ)). Кластерный принцип организации полупроводникового производства.

Методы очистки исходных материалов и структур; оборудование, применяемое для очистки.

Технология и оборудование для выращивания монокристаллов. Особенности конструктивного выполнения ТО и его основных узлов и систем. Особенности выращивания из расплава элементарных полупроводников. Оп-

тимизация равномерного распределения легирующих примесей в монокристаллах. Технология и оборудование получения полупроводникового кремния и германия. Выращивание монокристаллов германия и кремния с совершенной структурой.

Особенности технологии полупроводниковых соединений. Методы контроля и стабилизации параметров процесса выращивания монокристаллов, система автоматического управления процессом.

Технология и оборудование для получения тонких пленок в вакууме: вакуум-термическое испарение, электронно-лучевое испарения, высокочастотное распыление диэлектриков, ПТ и ВЧ магнетронное распыление, реактивное ионное распыление, Осаждение пленок в плазме из парогазовых смесей. Особенности проектирования, расчета и моделирования узлов и систем технологического оборудования нанесения пленок. Методы и оборудование осаждения пленок сложного состава, реактивное распыление материалов.

Технология и оборудование для получения эпитаксиальных слоев. Принципиальные схемы проведения эпитаксиальных процессов. Промышленные методы эпитаксиального наращивания и виды применяемого оборудования. Эпитаксия при пониженных давлениях, молекулярно – лучевая эпитаксия. Технические требования, предъявляемые к оборудованию. Типы промышленных установок. Методы контроля и стабилизации параметров эпитаксиальных процессов. Микропроцессорное управление процессами эпитаксии. Моделирование работы эпитаксиального оборудования. Алгоритмы и программы расчета и моделирование процесса и основных элементов ТО эпитаксии.

Технология и оборудование для создания р-п переходов. Методы получения р-п переходов, гетеропереходов и переходов металл—полупроводник. Диффузионные методы легирования. Ионное легирование (имплантация). Оборудование для процессов ионной имплантации.

Основы технологии контактной, дуговой, холодной сварки и пайки. Методы получения вакуумноплотных соединений. Клеевые соединения. Методы контроля герметичности. Оборудование для создания межсоединений и герметизации готовых приборов. Пластмассовая герметизация полупроводниковых приборов, ИМС. Методы пассивации и защиты полупроводниковых приборов и ИМС. Технология и оборудование для пластмассовой герметизации ИЭТ.

Методы и технология откачки и газозаполнения электровакуумных и газоразрядных приборов. Откачка удалением и связыванием. Криогенная откачка. Вакуумное технологическое оборудование для формирования остаточной вакуумной среды в электронных приборах.

Термохимическое оборудование в производстве электровакуумных в полупроводниковых приборов. Принципы расчета и проектирования.

Электротермические устройства и системы. Принципы расчета и проектирования. Оборудование для получения диффузионных и диэлектрических слоев в термопечах. Требования процессов диффузии, окисления и осаждения из паро- газовых смесей к ТО. Особенности конструкций компонентов: термопечей, элементов газо-вакуумных систем, устройств утилизации продуктов реакций и др. Основы инженерного расчета газовых систем. Автоматическое управление диффузионной печью. Моделирование процессов и устройств получения диф- фузионных диэлектрических слоев.

Методы и оборудование травления микроструктур: ионное, реактивное ионное и плазмохимическое с использованием постоянного тока, ВЧ и СВЧ разрядов. Физика процессов, особенности проектирования и моделирования процессов, узлов и систем ТО. Системы с электронно-циклотронным резонансом. Методы анизотропного травления полупроводников (Bosh-процесс, ICP-процесс).

Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки. Прецизионное электроэрозионное оборудование для обработки деталей электронных приборов. Ультразвуковое оборудование для очистки поверхности и обработки хрупких материалов. Оборудование для обработки лучом лазера. Технология и оборудование электрохимической обработки.

Современное аналитическое вакуумное оборудование. Методы получения высокого вакуума. Вторично-ионные масс-спектрометры, Оже-спектрометры, оборудование, использующее рентгеновское и лазерное излучение.

Литографические процессы в производстве полупроводниковых приборов. Анализ точности литографического процесса и определение требований к ТО. Сопоставительный анализ предельных возможностей процессов и ТО литографии, основанных на применении ультрафиолетового, лазерного и рентгеновского излучений, электронных и ионных пучков. Схемы процессов проектирования и формирования изображений на пластинах в производстве интегральных микросхем.

Оборудование оптической литографии (генераторы изображений, фотоповторители, установки совмещения и экспонирования и др.). Влияние дифракции и аберраций оптических систем на качество изображения. Методы машинного расчета влияния аберраций. Прецизионные системы координатных перемещений. Алгоритмы и программы расчета оптических систем и систем координатных перемещений.

Электронная литография. Классификация и принципиальные схемы электронно-лучевых и проекционных установок электронной литографии. Влияние различных факторов на качество изображения: aberrаций, рассеяния электронов, эффектов близости и т.д. Конструкции, методы проектирования, расчета и моделирования основных узлов ТО электронной литографии: электронных пушек, систем формирования, переноса и отклонения пучков, систем совмещения, систем перемещения и позиционирования пластин. Современные проблемы и тенденции развития ТО электронной литографии.

Ионно-лучевая литография (ИЛЛ). Направления развития ТО ИЛЛ и особенности создания систем экспонирования коллимированным ионным пучком (ИП), острое/фокусированным ИП и систем модульной ионной проекции изображения. Конструкции, сравнительные характеристики, методы расчета и моделирования основных узлов и систем ТО ИЛЛ: ионных источников, отклоняющих и сканирующих систем, систем ускорения и фокусировки.

Основные требования технологических процессов сварки и пайки к ТО сборки монтажа микросхем. Конструктивное выполнение установок, основных узлов и систем. Принципы расчета и проектирования узлов монтажно-сборочного оборудования. Критерии подобия сварочных процессов и их применения при проектировании оборудования.

**Вопросы для кандидатского экзамена по научной специальности
05.27.06 Технология и оборудование для производства полупроводников,
материалов и приборов электронной техники**

1. Оборудование для выращивания кристаллов: высокотемпературные ростовые системы с резистивным и индукционным нагревом; высокотемпературные ростовые системы с контролируемой атмосферой.
2. Зонная теория твердого тела. Энергетические спектры электронов в металлах, полупроводниках, диэлектриках. Зона проводимости и валентная зона. Эффективная масса электрона и дырки. Собственные и примесные полупроводники. Роль донорных и акцепторных примесей.
3. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Инверсная заселенность. Методы создания инверсной заселенности. Оптический квантовый генератор. Трехуровневая схема. Четырехуровневая схема. Основные части лазера. Возможные потери энергии в лазере. Непрерывные и импульсные лазеры. Оптические затворы. Моды излучения. Перестройка длины волны лазера. Классификация лазеров.
4. Методы и оборудование для выращивания монокристаллов. Особенности выращивания из расплава элементарных полупроводников. Оптимизация равномерного распределения легирующих примесей в монокристаллах.
5. Методы анализа материалов электроники: термические методы, оптическая спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния, рентгеноструктурный анализ, методы анализа состава и микропримесей, электронная микроскопия.
6. Устройство оптоволоконного световода. Основные параметры световода. Спектральная зависимость потерь в световоде. Виды оптоволоконных световодов и области их применения. Световоды среднего ИК-диапазона.
7. Исходные вещества, используемые для производства монокристаллов и пленок. Особо чистые вещества и материалы, их роль в современной технике. Понятие о чистоте вещества, методы определения и оценка чистоты. Физико-химические основы и методы глубокой очистки веществ. Понятие о коэффициенте разделения и распределения.
8. Электропроводность полупроводников. Поведение свободных носителей заряда в слабом электрическом поле. Взаимодействие с фононами, примесными атомами, дефектами. Подвижность электронов и дырок. Условие электронейтральности. Диффузия и дрейф носителей заряда. Соотношение Эйнштейна. Свобод-

ные носители заряда в сильном электрическом поле. Горячие электроны. Лавинное умножение в полупроводниках. Эффект Ганна.

9. Сравнительный анализ методов нанесения тонких пленок в вакууме. Особенности получения наноразмерных пленок органических и неорганических веществ.
10. Полупроводниковые соединения $A^{III}B^V$, $A^{II}B^{VI}$ и $A^{IV}B^{VI}$: Влияние отклонения от стехиометрии на электрофизические свойства монокристаллов и эпитаксиальных структур. Получение монокристаллов и эпитаксиальных пленок на их основе и области их применения.
11. Неорганические и органические материалы для светоизлучающих приборов, приборов передачи и отображения информации.
12. Методы исследования реальной структуры кристаллов. Методы оценки структурного совершенства кристаллов. Методы исследования наноструктур: электронная микроскопия, оптика ближнего поля; туннельная и атомно-силовая микроскопии.
13. Методы и технологии создания контролируемой газовой атмосферы, в том числе при пониженном давлении, в электровакуумных и газоразрядных приборов. Вакуумное технологическое оборудование для формирования остаточной вакуумной среды в электронных приборах.
14. Принципы организации чистых производственных помещений при производстве материалов и изделий электронной техники. Кластерный принцип организации полупроводникового производства
15. Сверхпроводящие материалы. Технология изготовления высокотемпературных сверхпроводящих материалов и области их применения для изделий электронной техники
16. Ниобат лития: Структура и фазовые превращения, физико-химические характеристики. Доменное строение, кристаллы с регулярной доменной структурой и их применение, монодоменизация кристаллов. Фазовая диаграмма ниобата лития и особенности технологии выращивания кристаллов.
17. Выращивание кристаллов из растворов в расплаве на примере калий-титанил-фосфата, бората бария или бората лития. Составы и требования к растворителям. Фазовые диаграммы и выращивание кристаллов из раствора в расплаве.
18. Кварц. Структура, полиморфные модификации, физико-химические свойства кварца. Области применения кристаллов. Выращивание крупных монокристаллов кварца гидротермальным методом. Технологические параметры, оказывающие наибольшее влияние на скорость роста и качество монокри-

сталлов.

19. Классификация органических материалов для электронной техники. Материалы для органических светоизлучающих диодных структур (ОСИД).
20. Монокристаллы ниобата бария-натрия и ниобата бария-стронция как электрооптические и фоторефрактивные материалы: физико-химические свойства, структура полиморфных модификаций.
21. Ферриты со структурой шпинели, граната, перовскита и гексаплюмбита. Би- и полиферриты. Основные методы получения кристаллов ферритов. Основные области применения ферритов. Физико-химические характеристики и методы получения монокристаллов железо-иттриевого граната. Дефекты в кристаллах. Получение монокристаллических эпитаксиальных пленок железо-иттриевого граната.
22. Корунд как важнейший функциональный и подложечный монокристалл. Основные физико-химические свойства, структура. Выращивание кристаллов Al_2O_3 методами Чохральского и Багдасарова, их достоинства и недостатки применительно к технологии корунда. Проблема тигельного материала. Дефекты в кристаллах, методы их контроля и способы устранения.
23. Получение очень крупных кристаллов корунда методом ГОИ. Получение кристаллов различных форм методом Степанова. Дефекты в кристаллах, методы их контроля и способы устранения.
24. Фианит, его основные свойства и сферы применения. Структурные модификации и способы их стабилизации, ЧСЦ. Выращивание кристаллов методом холодного контейнера.
25. Лазерные материалы со структурой граната. Иттрий-алюминиевый гранат: структура, важнейшие физические свойства. Диаграмма плавкости и факторы, благоприятствующие кристаллизации гранатовой фазы. Методы выращивания, характерные ростовые дефекты и методы борьбы с ними.
26. Лазерная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната. Термодиффузионное получение композитных активных элементов.
27. Разупорядоченные кристаллические матрицы для редкоземельных ионов.
28. Лазерные стекла и волокна. Неодимовый лазер на стекле, иттербиевые волоконные лазеры.
29. Лазерные кристаллы, легированные переходными 3d-ионами ($Ti^{3+}:Al_2O_3$, $Cr^{3+}:BeAl_2O_4$, $Cr^{4+}:Y_3Al_5O_{12}$, $Cr^{4+}:Mg_2SiO_4$). Проблемы управления зарядовым состоянием ионов-активаторов.

30. Лазерные кристаллы фторидов: общие отличительные особенности физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств, преимущества и недостатки по сравнению с оксидными кристаллами. Фторидная лазерная керамика и нано-стеклокерамика.